U Texas Instruments

摘要

本用户指南介绍了 TMAG5170D 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。该 EVM 用于评估 TMAG5170D 的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语与 TMAG5170DEVM 具有相同的含义。本文档包括原理 图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。



| 1 | 概述 | 2 |
|---|-----------------------|----|
| | | 2 |
| | 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档 | 2 |
| 2 | 硬件 | 3 |
| | 2.1 特性 | 3 |
| 3 | 操作 | 3 |
| - | 3.1 快速启动设置 | 3 |
| | 3.2 EVM 操作 | 4 |
| 4 | | 12 |
| | 4.1 原理图 | |
| | 4.2 PCB 布局 | 15 |
| | 4.3 物料清单 | 17 |
| | | |

内容

商标

Firefox[™] is a trademark of Mozilla Foundation. Google Chrome[™] is a trademark of Google LLC. Windows[®] is a registered trademark of Microsoft Corporation. 所有商标均为其各自所有者的财产。



1 概述

TMAG5170D 是一款双芯片 3 轴线性霍尔效应传感器。该器件在每块芯片的 X、Y 和 Z 轴中集成了三个独立的霍 尔传感器。精密模拟信号链和集成的 12 位 ADC 对测量的模拟磁场值进行数字化。在系统校准期间可以进一步配 置该器件,以选择适合磁体强度和元件放置的三个磁场范围之一。

| 表 1-1. TMAG5170D 器件概要 | | | | |
|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| 产品 | 灵敏度范围选项 | | | |
| TMAG5170DA2 | +75mT、+150mT、+300mT | | | |

TMAG5170DA1 尚不可用,目前未安装在 EVM 上。

1.1 套件内容

表 1-2 列出了 EVM 套件的内含物。如果缺少任何元件,请联系最近的德州仪器 (TI)产品支持中心。

| 品类 | 数量 | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| TMAG5170DEVM | 1 | | | | |
| 3D 打印旋转和按压模块 | 1 | | | | |
| 手持磁铁 | 1 | | | | |

1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档

本用户指南可从 TI 网站获得, 文献编号为 SBAU420。附加到文献编号的任何字母对应于撰写本文档时已有的最 新文档修订版。较新的修订版可从 www.ti.com 上获得,也可从德州仪器 (TI) 文献响应中心 (电话为 (800) 477-8924)或产品信息中心(电话为(972)644-5580)获得。订购时,可通过文档标题或文献编号识别文档。表 1-3 列出了与 EVM 相关的文档。可以通过点击表 1-3 中的链接来获取更多信息。器件名称链接至 www.ti.com 上 的产品网络文件夹。文献编号链接到 PDF 文档。

表 1-3. 相关文档

| 文档标题 | 文档文献编号 | | |
|---------------------|---------|--|--|
| TMAG5170D-Q1 数据表 | SLYS052 | | |
| TI-SCB 用户指南 | SLAU839 | | |
| TMAG5170 EVM 快速入门视频 | — | | |

2 硬件

该 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5170D 的主要特性和性能。该 EVM 包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入寄存器以及查看和保存测量结果。另外还包括一个 3D 打印旋转和按压模块,用于通过单个器件测试角度测量和按钮的常用功能。

该 EVM 旨在对这些器件的基本功能进行评估。此布局并不用作目标电路的模型,也不作为针对电磁兼容性 (EMC)测试进行布局的模型。该 EVM 安装了两个具有不同灵敏度的 TMAG5170D,可以根据需要将其拆分为两 个单独的板。可以将该 EVM 连接到 TI-SCB,但也可以根据需要用作独立器件。

2.1 特性

- 拆分 PCB 以评估 TMAG5170DA2 灵敏度
- GUI 支持读取和写入器件寄存器以及查看和保存测量结果
- 3D 打印旋转和按压模块
- 用于电源的 Micro-USB 连接器

3 操作

3.1 快速启动设置

若要设置并使用 EVM,请遵循以下步骤:

- 1. 下载并安装 PAMB Windows[®] USB 驱动程序:http://www.ti.com/lit/zip/sbac253。
- 2. 将 EVM 连接到传感器控制板 (TI-SCB) (请参阅图 3-1)。
- 3. 使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。
 - a. 将 Micro-USB 电缆插入 TI-SCB 控制器板载 USB 插座 J2。
 - b. 将该 USB 电缆的另一端插入 PC。
- 4. 在 Firefox[™] 或 Google Chrome[™] 浏览器中通过以下链接访问 GUI:
 - a. TMAG5170DEVM GUI : https://dev.ti.com/gallery/search/TMAG5170D
- 5. 通过寄存器映射设置配置器件:
 - a. 点击 Write Config to Both
 - b. 将 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 OPERATING_MODE 设为"主动测量模式"(0b101)
 - c. 将 SENSOR_CONFIG 寄存器中的 MAG_CH_EN 设为 "XYZ" (0b0111)
- 6. 导航到 Plots 面板并点击 Collect Data
- 7. 通过执行以下操作之一向传感器施加磁场:
 - a. 在传感器周围挥动随附的手持磁体。
 - b. 将旋转和按压模块连接到 EVM 以进行使用(请参阅图 3-10)。有关如何使用该模块的更多详细信息,请参阅节 3.2.2。
- 8. 在 GUI 中观察输出。有关 GUI 设置和操作的更多信息,请参阅节 3.2.1.3。

3.2 EVM 操作

要将 EVM 与随附的 TI-SCB 控制器配合使用,请按照图 3-1 所示连接 EVM。



图 3-1. TI-SCB 控制器上的 EVM

可以选择将 TMAG5170DEVM 拆分为两半,即 TMAG5170DA1 和 TMAG5170DA2。要将 PCB 拆分为两半,请 在图 3-2 中所示的边界处弯曲 PCB。





图 3-2. TMAG5170DEVM 拆分边界

3.2.1 设置

3.2.1.1 驱动程序安装

下载并安装 PAMB Windows USB 驱动程序: http://www.ti.com/lit/zip/sbac253。每台计算机只需执行一次该步骤。解压缩文件夹并以管理员权限运行.exe 文件。

3.2.1.2 固件

GUI 可将固件加载到 TI-SCB 中,如节 3.2.1.3.1 所述。固件更新将通过 GUI 推送(需要安装驱动程序)。下载的 离线 GUI 可能会根据版本检查是否存在 GUI/固件更新。

3.2.1.2.1 固件调试

如果由于任何原因固件损坏或必须手动重新安装固件,请按照以下步骤重新安装固件。TMAG5170 EVM 快速入门 视频中演示了这些步骤:

- 1. 将 TI-SCB 控制器上的 MCU 配置为器件固件更新 (DFU) 模式。
 - a. MCU 可能已经进入 DFU 模式。如果是这样,GUI 将通知您,并在 GUI 连接到 PC 后尝试将固件更新到 最新版本。
 - b. 在 TI-SCB 控制器通电的情况下,可以通过以下方法之一手动进入 DFU 模式:
 - 通过软件:
 - 在 TI-SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令 "bsl"。
 - 通过硬件:
 - 确保 TI-SCB 已通过 USB 连接到 PC
 - 在按下 RESET 按钮的同时,用一把镊子(或一根导线)将接头引脚的 PK1 和 PK2 附近的两个测 试点(请参阅图 3-3)短路。





图 3-3. 用于手动进入 DFU 模式的测试点

- c. 如果成功, LED D1 和 D2 将熄灭。
- 2. MCU 进入 DFU 模式后,通过 GUI 上传固件:
 - 打开 File 菜单, 然后选择 Program Device
 - 将启动固件更新
 - GUI 重新启动后, TI-SCB 应自动连接

如果固件未能成功编程,TI建议连接计算机上的另一USB端口重复以上步骤。



3.2.1.3 GUI 设置和使用

在 Firefox 或 Google Chrome 浏览器中通过以下链接访问 GUI:

• TMAG5170DEVM GUI : https://dev.ti.com/gallery/search/TMAG5170D

3.2.1.3.1 初始设置

首次设置 GUI 时请遵循以下步骤:

- 1. 确保上述驱动程序已成功安装,以保证一切正常工作,并且 GUI 可以在必要时更新 EVM 固件。
- 2. 将 EVM/TI-SCB 控制器单元插入 PC 后,转到 GUI 链接:
- 3. 要通过网络浏览器启动 GUI,请点击 GUI Composer 应用程序,以打开 GUI Composer 窗口(请参阅图 3-4)。



图 3-4. GUI Composer 应用程序窗口

a. 首次设置 GUI Composer 时,请根据提示下载 *TI Cloud Agent* 和浏览器扩展(请参阅图 3-5)。这些提示 将在关闭 README.md 对话框后出现。

TI Cloud Agent Installation

Hardware interaction requires additional one time set up. Please perform the actions listed below and try your operation again. (What's this?)



图 3-5. TI Cloud Agent

4. (可选)点击 👱 图标(位于 GUI Composer 窗口中)下载 GUI 以供离线使用(请参阅图 3-4)。



3.2.1.3.2 GUI 操作

若要操作 GUI,请执行以下步骤:

- 1. 按照节 3.2.1.3.1 所述连接和启动 GUI。
- 2. 将 EVM 连接到 GUI 后,关闭 README.md 文件页面。靠近 GUI 左下角的文本应为 Hardware Connected (请参阅图 3-6)。



图 3-6. 硬件已连接

a. 如果 GUI 的左下角未显示 *Hardware Connected*,请在 *Options* → *Serial Port* 下检查不同的硬件 COM 端 口(请参阅图 3-7)。



图 3-7. 更改串行端口

- b. 如果硬件仍然没有连接,请确保使用的 GUI/EVM 组合正确无误。
- 点击图 3-8 所示的 Registers 图标(左侧的菜单中也提供了该图标),以查看寄存器映射,更改器件设置,并 启用寄存器自动读取。TMAG5170D内的每个芯片可以使用器件选择功能进行独立配置,也可以将两个传感 器配置为相同的寄存器设置(如果需要)。有关寄存器或寄存器位字段的问题,请选择 ² 图标。有关寄存器 的更多问题,请查看数据表。



Registers

Low level register read and write operations

图 3-8. "Registers"页面图标

4. 点击 Plots 图标,可查看并保存结果寄存器中的图形数据(请参阅图 3-9)。左侧的菜单也提供了该图标。



Plots for device outputs

图 3-9. "Plots"页面图标



3.2.2 旋转和按压演示

要使用旋转和按压演示,请执行以下步骤:

1. 将旋转和按压模块连接到 EVM, 如图 3-10 所示。



图 3-10. EVM 上的旋转和推送模块

2. 在 GUI 寄存器页面中:

- a. 此时, "Rotate & Push" GUI 将仅显示寄存器映射页面上所选器件的结果。
- b. 确保 "DEVICE_CONFIG" → "OPERATING_MODE"显示 (TRIGGER_MODE Active)。
- c. 确保 "SYSTEM_CONFIG" → "TRIGGER_MODE" 设置为默认值。
- d. 在 SENSOR_CONFIG 寄存器下:
 - i. 确保 X 和 Y 通道均已启用 (MAG_CH_EN)。
 - ii. 对于 A1 版本,将 X_RANGE 和 Y_RANGE 设置为 ±100mT,对于 A2 版本,将其设置为 ±133mT。
 - iii. 可选:将 ANGLE_EN 设置为 X-Y 角度计算。
- e. 在寄存器映射顶部,将 Auto Read 设置为 As fast as possible。
- 3. 转到 "Plots" 页面中的 Rotate & Push 选项卡 (请参阅图 3-11)。



图 3-11. "Rotate & Push" GUI 页面

- 4. 如果按钮 LED 没有在每个角度触发或在不应该触发时触发,请通过执行以下操作来校准该模块:
 - a. 进行所需设置来运行演示后,将模块缓慢旋转 360°,并使用 "Plots"页面记录 X 和 Y 通道的最小和最大磁场测量值(以 mT 为单位)的绝对值。
 - b. 将 Rotate & Push 选项卡中的 Push threshold calibration 值调整至大约比上面记录的最大值大 3mT 至 5mT。

3.2.2.1 优化器件角度匹配

每个 3D 霍尔效应传感器都装配在一个芯片上,封装组件将这些芯片垂直堆叠以便在 XY 平面中实现最小偏移。应 消除器件关于灵敏度增益和偏移的容差:



- 1. 在两个器件上采集一个完整旋转过程的数据,为实现尽可能小的输入参考噪声,将平均值设置为 32x。设置器件以使用所需的轴来计算角度。
- 2. 在每个器件上校正一个轴的增益:
 - a. 查找角度测量中使用的每个轴的最大和最小数据点
 - b. 如果任一通道的最大值大于另一个通道的最大值的 2 倍,则需要减弱具有较大输入的通道。否则, TI 建议 放大较小输入的输出
 - c. MAG_GAIN_CONFIG 寄存器 (0h11) 中的 GAIN_VALUE 用于为所需轴选择灵敏度增益调整。
 - i. 增益根据一个 11 位值 / 1024 计算得出 (对于 0-2 范围内的值)
 - ii. 使用 GAIN_SELECTION 选择要放大/减弱的轴
 - iii. 根据以下比率设置增益值:
 - 1. (最大通道 A 最小通道 A)/(最大通道 B 最小通道 B)。
 - 2. 其中的通道 A 和 B 根据步骤 2b 进行选择。
- 3. 重复步骤 1 以确认幅度匹配并开始计算偏移校正
 - a. 对于每个轴,使用以下公式计算偏移:
 - i. 输出偏移 = (最大值 + 最小值) / 2
 - b. 将 MAG_OFFSET_CONFIG (0h12) 中的 OFFSET_SELECTION 设置为 0b11 以便在两个轴上启用偏移 校正
 - c. 使用一个 7 位 2 的补码值来设置 OFFSET_VALUE1 和 OFFSET_VALUE2,以根据步骤 3a 中的最大和最 小峰值数据校正输出偏移

在校正器件的灵敏度和偏移误差之后,由于封装与旋转磁体之间存在相对的机械旋转,传感器可能仍会出现一定 的测量误差。最直接的对齐方法是将传感器与旋转磁体放置在同一轴上。



图 3-12. 传感器对齐以进行角度测量

在理想的同轴放置方案中,X和Y轴数据只会观察到幅度下降,而不会影响观察到的角度线性度。由于封装有机 械偏移,X轴和Y轴的峰值输入数据将发生变化,因此所需的幅度校正强度将变得更加显著。此外,封装旋转可 能会导致其相对于磁体位置存在角度偏移,或导致观察到的X轴和Y轴输入之间存在相位误差。当每个传感元件 检测到与传感元件正交的磁场并且传感器不再与旋转磁体正交时,就会发生这种情况。因此,每个传感元件会从 其他两个轴中的任何一个轴检测到矢量分量的一部分。此误差可能因系统中磁体或传感器的安装方式而异。通 常,在整个系统组装完成后,需要对每个传感器进行下线校准,以获得理想结果。如需了解更多信息,请参阅德 州仪器 (TI)的*实现超高系统角度传感精度*应用手册。

操作

3.2.3 直接 EVM 串行通信

如果需要,您可以通过 USB 串行 (COM) 端口直接与 TI-SCB 进行通信,而无需使用 GUI。可以通过串行端口直 接发送所需的命令字符串,并接收结果。这有助于通过自定义设置、脚本和 GUI 连接 EVM。要读取和写入寄存 器,请使用以下格式:

- 选择器件格式:setdevice CMD
 - 其中的 CMD 是作为整数值 (0-3) 发送的两位命令。
 - **00** = 从器件 1 读取/写入
 - 01 = 从器件 2 读取/写入
 - 10 = 写入到两个器件;从器件1读取
 - 11 = 写入到两个器件;从器件 2 读取
 - 写入两个器件并从器件 1 读取的有效设置命令为:
 - Setdevice 0x02
 - 在 EVM 上,可使用此命令共享 SDI 和 SDO 线路并控制 CS。MCU 可以使用两次连续写入向每个器件发送 相同的写入命令,但读取数据由 MCU 单独记录。
- 读取寄存器格式:rreg ADR
 - 其中 ADR 是十六进制地址, rreg 始终小写
 - 寄存器地址可以是大写或小写,并且不需要以"0x"开头。也可以选择用0填补寄存器地址。例如,要读 取寄存器地址 0xA,某些有效的命令包括:
 - rreg a
 - rreg 0A
 - rreg 0x0A
 - 使用 "0x" 时 , "x" 必须小写。
 - 在上述示例中, EVM 会返回 JSON 格式的结果

{"acknowledge":"rreg 0x0A"}

{"register":{"address":10,:"value":65488}}

{"evm_state":"idle"}

- 写入寄存器格式: wreg ADR VAL
 - 其中 ADR 和 VAL 采用十六进制, wreg 始终小写
 - 寄存器地址和值可以是大写或小写,并且不需要以"0x"开头。也可以选择用 0 填充寄存器地址和值。例如,要向寄存器地址 0x1 写入值 0x01c0,某些有效的命令包括:
 - wreg 1 1c0
 - wreg 01 0x1c0
 - wreg 0x01 0x01C0
 - 使用"0x"时,"x"必须小写。
 - 在上述示例中, EVM 会返回 JSON 格式的结果:

{"acknowledge":"wreg 0x01 0x01C0"}

{"console":"Writing 0x1c0 to SENSOR_CONFIG register"}

{"evm_state":"idle"}



4 原理图、PCB 布局和物料清单

备注

电路板布局未按比例显示。这些图旨在显示电路板的布局。而不用于制造 EVM PCB。



4.1 原理图

图 4-1 和图 4-2 显示了 EVM 的原理图。图 4-1 显示了 EVM 的电路,图 4-2 显示了随 EVM 提供的机械部件。



图 4-1. TMAG5170DEVM 原理图









LOGO WEEE logo

图 4-2. 硬件原理图

4.2 PCB 布局

图 4-3 至图 4-6 显示了 EVM 的各 PCB 层。



图 4-3. 顶视图



图 4-4. 顶层





图 4-5. 底视图



图 4-6. 底层



4.3 物料清单

表 4-1 提供了 EVM 的器件列表。

| 名称 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|--|----|-------|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| !PCB1 | 1 | | 印刷电路板 | | SENS107 | 不限 |
| C1、C2、C6、C7 | 4 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1 μ F,6.3V,+/-10%, X5R,0201 | 0201 | GRM033R60J104KE19D | MuRata(村田) |
| C3、C5、C8、C10 | 4 | 1uF | 电容,陶瓷,1 μ F,16V,+/-10%,X5R, 0402 | 0402 | EMK105BJ105KVHF | Taiyo Yuden |
| C4、C9 | 2 | 10nF | 10000pF ±20% 16V 陶瓷电容器 X5R 01005 (公制 0402) | 010005 | CM02X5R103M16AH | AVX |
| D1、D2、D3、D4 | 4 | Rg | LED , Rg , SMD | 1.6x0.8mm | HSMF-C165 | Avago(安华高) |
| J3 , J6 | 2 | | | HDR12 | NRPN062PARN-RC | Sullins Connector Solutions |
| R1、R2、R9、R10、R11、 R12、R13、R20、R21、R28、 R29、R30、R31、R32 | 14 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
| R3、R5、R22、R24 | 4 | 150 | 电阻,150,5%,0.05W,0201 | 0201 | RC0201JR-07150RL | Yageo America(国巨 美国) |
| R4、R6、R23、R25 | 4 | 215 | 电阻,215,1%,0.05W,0201 | 0201 | RC0201FR-07215RL | Yageo America(国巨 美国) |
| R7、R8、R26、R27 | 4 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0402 | 0402 | ERJ-2RKF1002X | Panasonic(松下) |
| R14、R15、R16、R17、R18、 R33、R34、R35、R36、R37 | 10 | 33.0 | 电阻,33.0,1%,0.05W,0201 | 0201 | RC0201FR-0733RL | Yageo America(国巨 美国) |
| U1 | 0 | | 具有 SPI 的双芯片高精度 3D 线性霍尔效应传感器 | TSSOP16 | TMAG5170DA1EPWRQ1 | 德州仪器 (TI) |
| U2 , U4 | 2 | | 单路输出 LDO,1A,可调节电压(1.2V 至 5.0V),反向电流保护,DRV0006A (WSON-6) | DRV0006A | TPS73733DRVR | 德州仪器 (TI) |
| U3 | 1 | | 具有 SPI 的双芯片高精度 3D 线性霍尔效应传感器 | TSSOP16 | TMAG5170DA2EPWRQ1 | 德州仪器 (TI) |
| FID1、FID2、FID3 | 0 | | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| J1、J4 | 0 | | 接头,100mil,4x1,金,TH | 4x1 接头 | TSW-104-07-G-S | Samtec(申泰) |
| J2、J5 | 0 | | | 接头,2.54mm,2x1, TH | 961102-6804-AR | ЗМ |
| R19、R38 | 0 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |

表 4-1. 物料清单



4.2 PCB 布局

图 4-3 至图 4-6 显示了 EVM 的各 PCB 层。



图 4-3. 顶视图



图 4-4. 顶层





图 4-5. 底视图



图 4-6. 底层

4.3 物料清单

表 4-1 提供了 EVM 的器件列表。

名称 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 PCB1 SENS107 1 印刷电路板 不限 电容,陶瓷,0.1 µ F,6.3V,+/-10%, 0201 C1、C2、C6、C7 4 0.1uF GRM033R60J104KE19D MuRata(村田) X5R,0201 电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X5R, 4 1uF 0402 EMK105BJ105KVHF C3、C5、C8、C10 Taiyo Yuden 0402 10000pF ±20% 16V 陶瓷电容器 X5R 01005 C4、C9 2 10nF 010005 CM02X5R103M16AH AVX (公制0402) 4 D1、D2、D3、D4 Rg LED, Rg, SMD 1.6x0.8mm HSMF-C165 Avago (安华高) Sullins Connector 2 HDR12 J3, J6 NRPN062PARN-RC Solutions R1、R2、R9、R10、R11、 R12、R13、R20、R21、R28、 14 0 0603 RC0603JR-070RL Yageo 电阻,0,5%,0.1W,0603 R29、R30、R31、R32 Yageo America(国巨 R3、R5、R22、R24 4 150 0201 RC0201JR-07150RL 电阻,150,5%,0.05W,0201 美国) Yageo America(国巨 0201 R4、R6、R23、R25 4 215 电阻,215,1%,0.05W,0201 RC0201FR-07215RL 美国) 0402 ERJ-2RKF1002X R7、R8、R26、R27 4 10.0k Panasonic (松下) 电阻,10.0k,1%,0.1W,0402 R14、R15、R16、R17、R18、 Yageo America(国巨 10 33.0 电阻,33.0,1%,0.05W,0201 0201 RC0201FR-0733RL R33、R34、R35、R36、R37 美国) 具有 SPI 的双芯片高精度 3D 线性霍尔效应传 U1 0 TSSOP16 TMAG5170DA1EPWRQ1 德州仪器 (TI) 感器 单路输出 LDO, 1A, 可调节电压 (1.2V 至 U2, U4 2 5.0V),反向电流保护,DRV0006A DRV0006A TPS73733DRVR 德州仪器 (TI) (WSON-6) 具有 SPI 的双芯片高精度 3D 线性霍尔效应传 U3 1 TSSOP16 TMAG5170DA2EPWRQ1 德州仪器 (TI) 感器 FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用 J1、J4 0 接头,100mil,4x1,金,TH 4x1 接头 TSW-104-07-G-S Samtec (申泰) 接头,2.54mm,2x1, 0 961102-6804-AR 3M 接头,2.54mm,2x1,金,TH J2、J5 TH RC0603JR-070RL 0 0 0603 R19、R38 电阻,0,5%,0.1W,0603 Yageo

表 4-1. 物料清单

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司